

GaN эпитаксиальные структуры

GaN эпитаксиальные структуры

Производитель:

АО «Диполь Технологии»

Цена:

Цена по запросу

Описание

Полупроводниковые структуры на основе нитрида галлия (GaN) и его соединений широко применяются в современной полупроводниковой электронике.

Основные достоинства этих соединений заключаются в прямозонности, сильных межатомных связях, а также в возможности изменения в широком диапазоне энергии фундаментального перехода.

Применение

На основе нитрид-содержащих полупроводниковых гетероструктур изготавливают высокоэффективные световые источники света в зелёном, синем ультрафиолетовом диапазонах оптического спектра, а также высокотемпературные и высокочастотные приборы.

Кроме того, часть сверхярких светодиодов, излучающих в синем и зелёном диапазонах, ультрафиолетовые детекторы и лазерные диоды в оптоэлектронных устройствах, сделанных на основе квантово-размерных структур GaN, успешно внедрены в производство.

Спецификация

GaN эпитаксиальные структуры

Структуры GaN с другими параметрами также доступны по запросу.